

安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

SS8050

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

Low Frequency Power Amplifier 低頻功率放大 Suitable for Driver Stage of Small Motor 小馬達驅動 Complementary to SS8550 与 SS8550 互补

■最大額定值(Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	Symbol	Rating	Unit
特性參數	符號	額定值	單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	40	Vdc
Collect-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	20	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$ m V_{EBO}$	5.0	Vdc
Collector Current 集電極電流	Ic	1500	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P _C	300	mW
Junction Temperature 結溫	T_{j}	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	$\mathrm{T_{stg}}$	-55∼150	°C

■DEVICE MARKING 打標

SS8050=Y1

■HFE RANGE 放大倍數分檔

 $H_{FE}(1)$ (85~150), (120~220) (200~300), (280~400)



安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

SS8050

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25°C)

(T _A =25°C unless otherwise n	oted 如無行	<u> </u>				
Characterstic	Symbol	Test Condition	Min.	Тур.	Max.	Unit
特性參數	符號	測試條件	最小值	典型值	最大值	單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=30V,I_{E}=0$	_		0.1	μ Α
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V,I_{C}=0$	_	—	0.1	μ A
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	I _C =100 μ A	40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	I _C =10mA	20	_	_	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	I _E =100 μ A	5	_	_	V
DC Current Gain 直流電流増益	H _{FE} (1)	$V_{CE}=1V$, $I_{C}=100mA$	85		400	
	$H_{FE}(2)$	V _{CE} =1V, Ic=1500mA	40	_	_	_
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	V _{CE(sat)}	I _C =1500mA, I _B =150mA	_		0.6	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	$ m V_{BE}$	$V_{CE}=1V$, $I_{C}=10mA$	_	0.8	1.0	V
Transition Frequency 特徴頻率	f_{T}	V_{CE} =5 V , I_{C} =10 mA	100	120	_	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	V _{CB} =10V,I _E =0, f=1MHz	_	13	30	pF

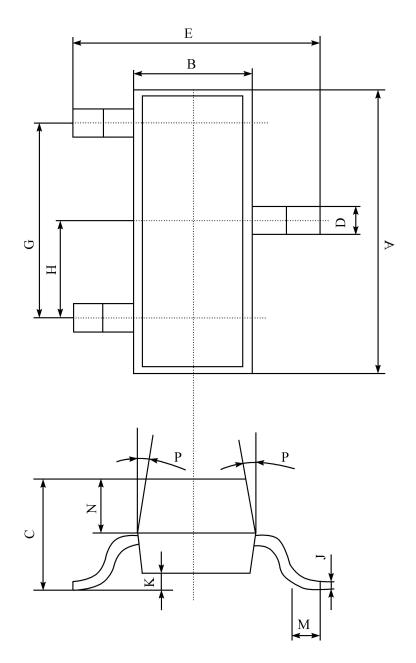


安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

SS8050

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
В	1.30 ± 0.10
С	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
Е	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
Н	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60 ± 0.10
P	7 ± 2°